

МОЩНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ ТРАНЗИСТОР

Применение:

Мощные преобразовательные устройства, схемы частотно-управляемых электроприводов и вторичных источников питания, схемы строчной развертки телеприемников и мониторов.

Описание:

Кремниевый меза-планарный n-p-n мощный высоковольтный переключательный транзистор 2Т8277А,Б в металлокерамическом корпусе КТ-9М



- **Предельно допустимые режимы эксплуатации**

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Примечание
		2Т8277А	2Т8277Б	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектора, В	$U_{КБ\ max}$	1500	1200	1
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В	$U_{КЭ0\ max}$	700	700	1
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ0\ max}$	10	10	1
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{К\ max}$	16	16	1
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{К,и\ max}$	22	22	1
Максимально допустимый постоянный ток базы, А	$I_{Б\ max}$	9	9	1
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температуре корпуса от минус 60°С до 25°С,Вт	$P_{К\ max}$	200	200	2
Максимально допустимая температура перехода, °С	$T_{п\ max}$	150	150	

Примечания:

1 В диапазоне температур корпуса от минус 60 °С до плюс 125 °С.

2 При температуре корпуса свыше 25 °С до плюс 125 °С рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле:

$$P_{K \max} = \frac{T_{п \max} - T_{корп}}{R_{Т п-к}}, \text{ Вт}$$

где $R_{Т п-к}$ – установившееся тепловое сопротивление переход-корпус, равное 0,63 °С/Вт.

• Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Букв. обознач	2Т8277А		2Т8277Б		Темпера тура °С
		не менее	не более	не менее	не более	
Обратный ток коллектора, мА ($U_{кбо} = 1500 \text{ В}$) ($U_{кбо} = 1200 \text{ В}$)	$I_{кбо}$		3,0 5,0 6,0			25 -60 125
					3,0 5,0 6,0	25 -60 125
Обратный ток эмиттер-база ($U_{бэ} = -10 \text{ В}$), мА	$I_{эбо}$		20		20	25
Статический коэффициент передачи тока ($U_{кэ} = 5 \text{ В}$, $I_{к} = 12 \text{ А}$,)	$h_{21э}$	7		7		25
		5		5		-60
		5		5		125
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_{к} = 12 \text{ А}$; $I_{б} = 3 \text{ А}$)	$U_{кэ \text{ нас}}$		1,2		1,2	25
			1,7		1,7	-60
			1,7		1,7	125
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_{к} = 12 \text{ А}$; $I_{б} = 3 \text{ А}$)	$U_{бэ \text{ нас}}$		1,5		1,5	25
Граничное напряжение ($I_{к} = 0,1 \text{ А}$, $L = 25 \text{ мГн}$), В	$U_{кэо \text{ гр}}$	700		700		25
Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт	$R_{Т п-к}$		0,63		0,63	

• Временные характеристики

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Букв. обознач.	2Т8277А		2Т8277Б		Темпера тура °С
		не менее	не более	не менее	не более	
Время рассасывания, мкс ($I_{б1} = 2 \text{ А}$, $I_{б2} = -6 \text{ А}$, $I_{к} = 12 \text{ А}$, $U_{к} = 400 \text{ В}$), мкс	$t_{\text{расс}}$		3,0		3,0	25
Время спада, мкс	$t_{\text{сп}}$		0,2		0,2	25

